

豊富なパッケージ・接点構成・機能を実現した
200機種以上に及ぶ強力なラインアップ充実！

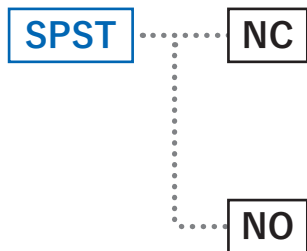


形G3VM

MOS FET リレー

MOS FET リレーモジュール

MOS FETリレー 商品セレクション



LED/PDA/MOS-FETを組み合わせてリレー機能を実現

絶縁しつつ信号伝達！ ランプ点灯

① LEDに電流を流し発光させ、 ② PDA (太陽電池) が発電し、 ③ MOS-FETがONする。

MOS FETリレー

低リーク電流機能を付与した **MOS FETリレー モジュール**

漏れ電流 I_{LEAK} vs 印加電圧 V_{DD}

G3VM-21MT 測定回路例



1c切り替え機能を付与した **MOS FETリレー モジュール**

MOS FETリレーモジュール SPDT接点構成タイプ

SPDT構成回路

有接点リレーとの対比

モジュール詳細はP3

	リードリレー	メカニカルリレー	Tモジュール 21MT	SPDTモジュール 66M	MOSFETリレー
接触信頼性 (ON抵抗)	△	△	◎	◎	◎
耐久性	○	△	◎	◎	◎
リーク電流	◎	◎	◎	△	△
アイソレーション	◎	◎	◎	×	×
1c接点	◎	◎	—	◎	—

MOS FETリレー 形式基準

G3VM-□□□□□□

① 負荷電圧	② 接点構成	③ 形状	④ 付加機能	⑤ 連番	⑥ 入力順電
2:20V 8:80V 3:30V 10:100V 4:40V 20:200V 5:50V 35:350V 6:60V 40:400V 7:75V 60:600V	1: 1a接点 2: 2a接点 3: 1b接点 4: 2b接点 5: 1a1b接点	A: DIP 4ピン プリント基板用端子 B: DIP 6ピン プリント基板用端子 C: DIP 8ピン プリント基板用端子 D: DIP 4ピン サーフェス・マウント端子 E: DIP 6ピン サーフェス・マウント端子 F: DIP 8ピン サーフェス・マウント端子 G: SOP 4ピン H: SOP 6ピン J: SOP 8ピン L: SSOP 4ピン P: USOP 4ピン Q: S-VSON 4ピン U: VSON 4ピン V: SOP 4ピン特殊 W: P-SON 4ピン	L: カレントリミット R: 低オン抵抗タイプ Y: 入出力間耐圧高タイプ =2.5kVを越える範囲 V: 電圧駆動タイプ	仕様が重複する場合は連番(数字)を追加しています。	H: 入力順電圧高い L: 入力順電圧低い *一部電圧駆動タイプのみ

注1. 一部商品の形式は、上記の形式基準と異なります。
 注2. l(英字)は1(数字)と混同する可能性があるため除いてあります。
 注3. マーキングスペースの都合で、SOP 4ピンで6桁以上の形式になり識別困難になる場合は、まず③の形状をマーキングから外しています。

MOS FETリレー 梱包種類

汎用パッケージ

パッケージの種類	A DIP4 スルー ホール	B DIP6 スルー ホール	C DIP8 スルー ホール	D DIP4 サーフェス・ マウント	E DIP6 サーフェス・ マウント	F DIP8 サーフェス・ マウント	G SOP4 サーフェス・ マウント	V SOP4 (特殊) サーフェス・ マウント	H SOP6 サーフェス・ マウント	J SOP8 サーフェス・ マウント
リール 梱包	/	/	/	TR:1500個 TR05:500個	TR:1500個	TR:1500個	TR:2500個 TR05:500個	TR:3000個 TR05:500個	TR:2500個 TR05:500個	TR:2500個
スティック 梱包	100個/本	50個/本	50個/本	100個/本	50個/本	50個/本	100個/本	125個/本	75個/本	50個/本

小型パッケージ(防湿梱包入り)

パッケージの種類	L SSOP サーフェス・ マウント	W P-SON サーフェス・ マウント	P USOP サーフェス・ マウント	U VSON サーフェス・ マウント	Q S-VSON サーフェス・ マウント
リール 梱包	TR05:500個	TR05:500個	TR05:500個	TR05:500個	TR05:500個
スティック 梱包	/	/	/	/	/

注1.スティック梱包がないパッケージはテーピングカットでの小口納入も対応しております。
 注2.スルーホールタイプはリール梱包品がありません。
 注3.テーピングカット品は防湿梱包していませんので、リフロー実装(自動実装)は出来ません。

パッケージ種類

DIP	SOP	SSOP	USOP	P-SON	VSON (R)	VSON	S-VSON
実装面積 100%とすると	実装面積 62%	実装面積 24%	実装面積 20%	実装面積 19%	実装面積 10%	実装面積 9%	実装面積 8% *VSONに対して84%

MOS FETリレーモジュール 形式基準

G3VM-□□□□□□

① 負荷電圧	② 接点構成	③ タイプ	④ 付加機能	⑤ その他
2: 20V 6: 60V 10: 100V	1: 1a接点* 6: SPDT接点*	M: MOS FETリレーモジュール	無し: 標準 T: Tスイッチ機能	仕様が重複する場合は連番(数字)を追加しています。

*詳細はデータシートをご参照ください。

PICK UP

MOS FETリレーモジュール SPDT接点構成タイプ

MOS FETリレー
SPDTモジュール

オムロン独自の技術*により、基板上に省面積で容易にSPDT接点構成を構築できる半導体リレーモジュールを実現しました。



形G3VM-26M10 (低C_{OFF}モデル)

高周波(≦300MHz)の信号切り替えに最適

形G3VM-26M11 (低R_{ON}モデル)

高電流(≦1A)のスイッチングに対応

形G3VM-66M (汎用モデル)

60V 0.4Aの出力側定格で幅広い用途に対応

有接点リレー*からの
置き換えに最適です

*リードリレー、メカリレー等

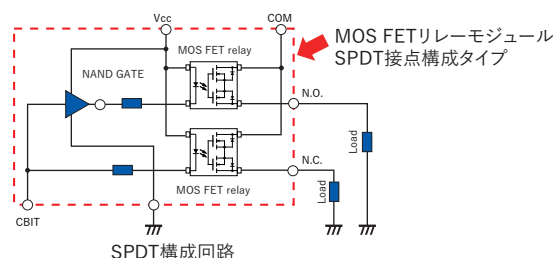
*2021年当社調べ

特長 1 工数削減

課題 半導体リレーを用いてSPDT接点を構成するには、複雑な回路と複数の部品が必要

解決 1パッケージ化により回路設計や部品選定の工数を削減

SPDT接点構成のために必要となる
複雑な回路一式をモジュール化。
基板設計の効率化や高密度実装が可能。

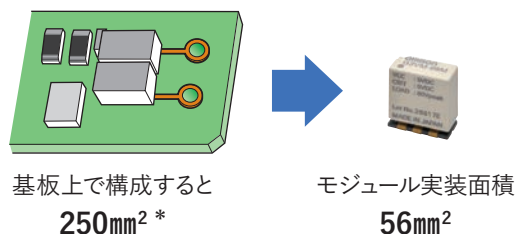


特長 2 スペース 5分の1

課題 半導体リレーを用いてSPDT接点を構成するには、広い基板スペースが必要

解決 独自パッケージ技術*による省面積構造で実装スペースを削減

基板上でSPDT回路を構成した場合と
比較して78%のスペースを削減。



*2021年当社調べ

特長 3 長寿命

課題 既存のSPDT有接点リレー(リードリレー、メカリレー等)は接点寿命があるため、定期メンテナンスが必要

解決 半導体リレー化により、長寿命化を実現し、定期メンテナンスの頻度を削減

半導体による無接点構造のためアーク放電なし。
機械的な摩耗故障が発生しない。



物理接点がないため
接点の摩擦故障が生じない

SPDTモジュール 商品ラインアップ

SPDTモジュール											
負荷電圧 (最大)(V)	形式	端子数	接点構成	連続負荷電流 (最大)(mA)	最大出力オン抵抗 (標準)(Ω)	開路時漏れ電流 (最大)(nA)	端子間容量 (標準)(pF)	動作時間 (最大)(ms)	復帰時間 (最大)(ms)	入力定格電圧 (V)	入出力間耐電圧 (Vrms)
20	形G3VM-26M10	6	SPDT	200	4.4	2	1	0.3	0.3	5	500
20	形G3VM-26M11	6	SPDT	1000	0.21	2	40	2.5	1.5	5	500
60	形G3VM-66M	6	SPDT	400	1	2	20	1	1	5	500

PICK UP

MOS FETリレーモジュール Tモジュールタイプ

MOS FETリレーを3個組み合わせた「T型回路構造」を1パッケージ化し、極小漏れ電流を実現しました。半導体試験装置などの測定精度向上に貢献します。



- 形G3VM-21MT (高アイソレーションタイプ)
- 形G3VM-61MT (高電流タイプ)
- 形G3VM-101MT (高電圧タイプ)

有接点リレー*からの置き換えに最適です

*リードリレー、メカリレー等

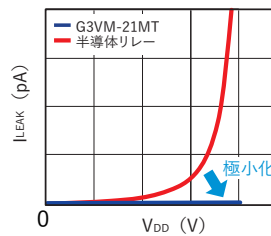
特長 1 測定精度向上

課題 半導体リレーには漏れ電流があり、微小電流測定精度が悪化

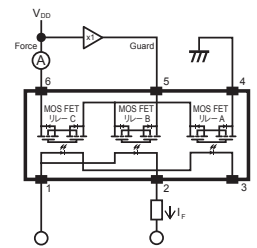
解決 T型回路構造により、漏れ電流 $\leq 1\text{pA}$ を実現し、微小電流の測定にも対応

実力値0.1pA以下で、計測機器の精度への影響を最小限に。

漏れ電流 I_{LEAK} vs 印加電圧 V_{DD}



G3VM-21MT 測定回路例



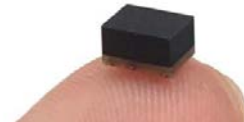
特長 2 省スペース化

課題 有接点リレーはサイズが大きく、広い基板スペースが必要

解決 超小型外形サイズで省スペース化を実現

複雑な回路を搭載しつつも極小サイズを実現、機器の高密度化に貢献します。

超小型外形サイズ
5mm×3.75mm×2.7mm



特長 3 長寿命

課題 既存の有接点リレー(リードリレー、メカリレー等)は接点寿命があるため、定期メンテナンスが必要

解決 半導体リレー化により、長寿命化を実現し、定期メンテナンスの頻度を削減

半導体による無接点構造のためアーク放電なし。機械的な摩耗故障が発生しない。



物理接点がないため
接点の摩擦故障が生じない

Tモジュール 商品ラインアップ

Tモジュール										
負荷電圧 (最大) (V)	形式	端子数	接点構成	連続負荷電流 (最大) (mA)	最大出力オン抵抗 (標準) (Ω)	開路時漏れ電流 (最大) (pA)	端子間容量 (標準) (pF)	動作時間 (最大) (ms)	復帰時間 (最大) (ms)	入出力間耐電圧 (V_{rms})
20	形G3VM-21MT NEW	6	1a*	200	8	1	0.6	0.3	0.3	500
60	形G3VM-61MT NEW	6	1a*	io Main : 800 io Sub : 400	0.4	1	38	2.5	0.5	500
100	形G3VM-101MT NEW	6	1a*	550	0.8	1	23	2.5	0.5	500

*詳細は、製品データシート「動作モード」をご確認ください

MOS FETリレー 商品セレクション

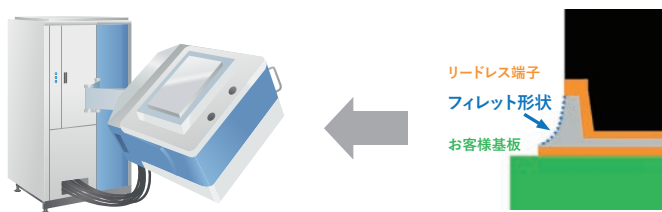
半導体検査装置へ推奨

DIPを実装面積100%とした場合

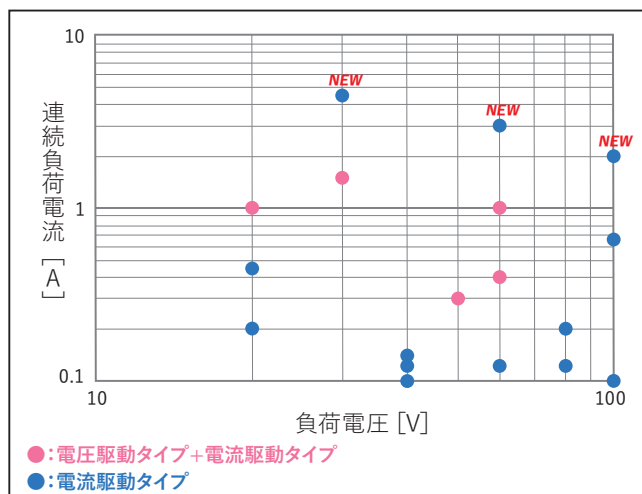
P-SON	VSON (R)	VSON	S-VSON
実装面積 19%	実装面積 10%	実装面積 9%	実装面積 8% *VSONに対して84%

高密度実装と特性を両立させる
MOS FETリレーをご提案

使いやすい500個/リール小型パッケージサイズ
ウェットプルフラック構造



フィレット形成により、実装強度の向上と
実装後のはんだ視認性が良好

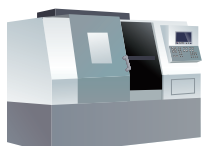


汎用 (FA, OA, Alarm, Communication)

DIP	SOP	SSOP	USOP
実装面積 100%とすると	実装面積 62%	実装面積 24%	実装面積 20%

FA機器を始めとした多用途に対して
MOS FETリレーをご提案

*UL認証品を多く取り揃えています。



産業機器



検知器

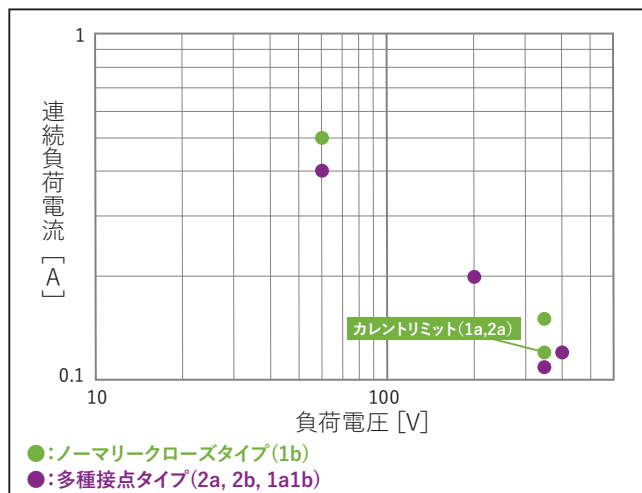
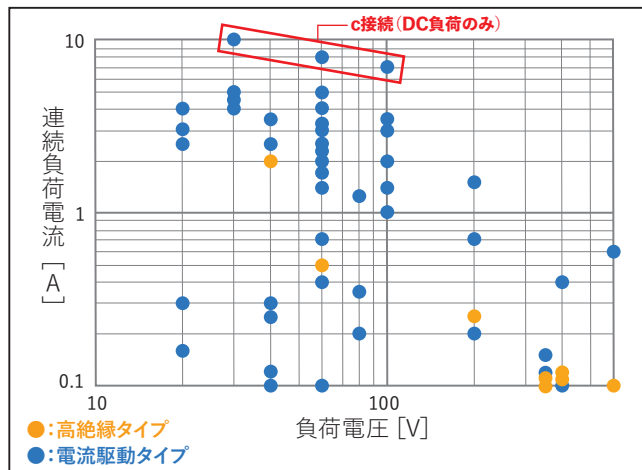


OA機器



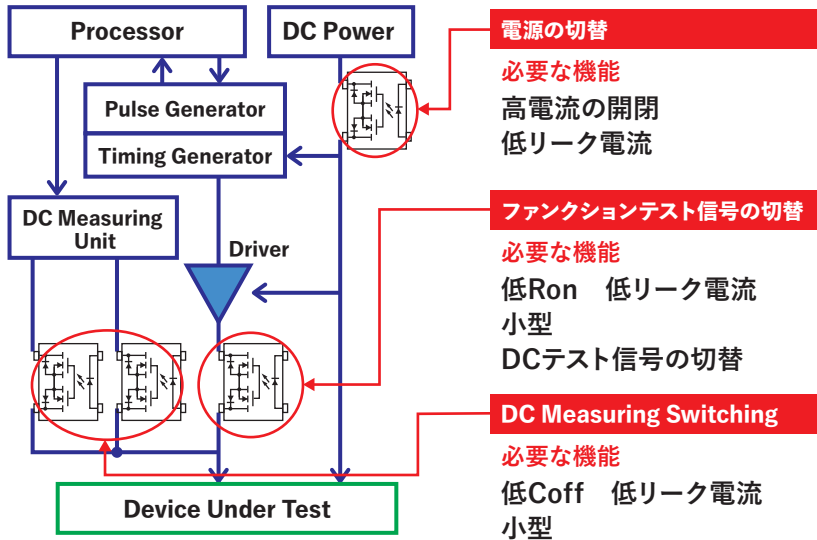
コントロールパネル

信号切り替えに適した多接点タイプ
常時通電時の消費電力低減へ
貢献する1b接点タイプ

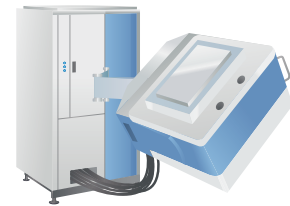


回路例

半導体検査装置の回路例

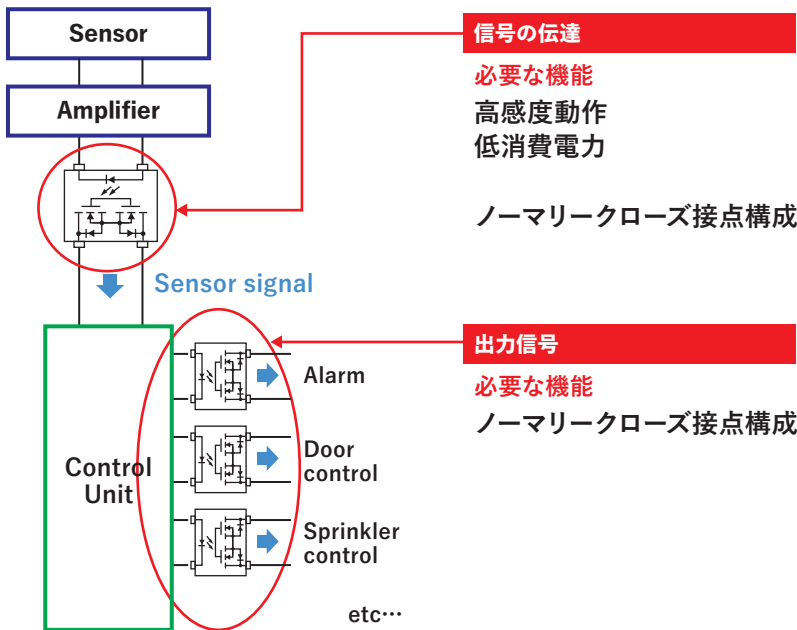


- 電源の切替**
必要な機能
高電流の開閉
低リーク電流
- ファンクションテスト信号の切替**
必要な機能
低Ron 低リーク電流
小型
DCテスト信号の切替
- DC Measuring Switching**
必要な機能
低Coff 低リーク電流
小型



- □ SONパッケージシリーズ etc.

センサーの回路例



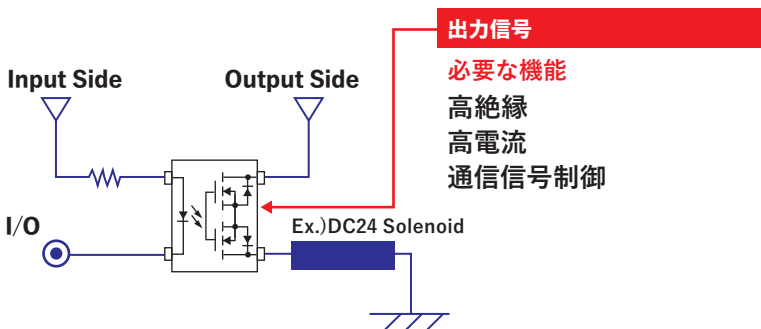
- 信号の伝達**
必要な機能
高感度動作
低消費電力

ノーマリークローズ接点構成
- 出力信号**
必要な機能
ノーマリークローズ接点構成

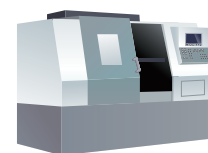


- 高感度タイプ
- ノーマリークローズタイプ(1b)
- ノーマリークローズタイプ(1b)

FA機器の回路例



- 出力信号**
必要な機能
高絶縁
高電流
通信信号制御

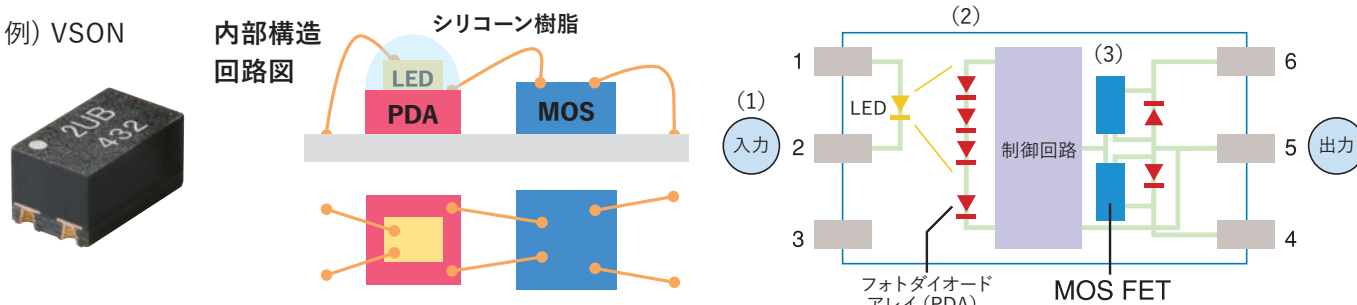


- 高絶縁タイプ
- 高容量タイプ
- 汎用タイプ

MOS FETリレー

MOS FETリレーとは出力素子にMOS FETを用いた光半導体デバイスで、メカニカルリレーの置き換えとしての採用が進んでいます。オムロンの半導体リレーでお客様のお悩みを解決します。

例) VSON



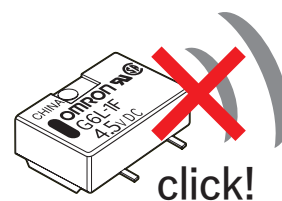
1. 入力側へ電流を通電するとLEDが発光。
2. その光を出力側のPDAが受光することで電圧へと変換。
3. この電圧がMOS FETのゲート電圧となり、MOS FETを駆動。

特長 1 静音

課題 既存の有接点リレー(リードリレー、メカリレー等)の動作音を取り除きたい

解決 機械接点のないMOS FETリレーのご使用で、無音動作を実現

メカリレーでオン動作時に接点のコンタクト音が発生するが、機械接点がない半導体構成のMOSFETリレーではコンタクト音がない。

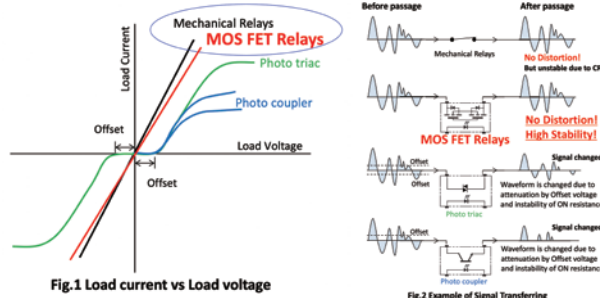


特長 2 優れたリニアリティ特性

課題 フォトランジスタ、フォトライアックを用いると、出力側信号に歪みが生じてしまう

解決 MOS FETリレーで、出力側信号の歪みを抑制

フォトランジスタ、フォトライアックの出力側素子はリニアリティが低いため、出力間を通過する信号に歪みが生じてしまうが、MOS FETリレーは優れたリニアリティ特性により、信号の歪みを抑制。



特長 3 長寿命

課題 既存の有接点リレー(リードリレー、メカリレー等)は接点寿命があるため、定期メンテナンスが必要

解決 半導体リレー化により、長寿命化を実現し、定期メンテナンスの頻度を削減

半導体による無接点構造のためアーク放電なし。
機械的な摩耗故障が発生しない。



新商品のご紹介 “P-SON”

SOP4よりも小型にも関わらず、より高電流の通電を可能としたP-SONシリーズをリリース。
お客様へ2つの価値“小型”と“高電流”を同時にご提供いたします。

パッケージ	形名仕様	接点	耐圧(V)	電流(A)
P-SON4	G3VM-31WR	1a	30	4.5
P-SON4	G3VM-61WR	1a	60	3
P-SON4	G3VM-101WR	1a	100	2

実装面積 約1/4!

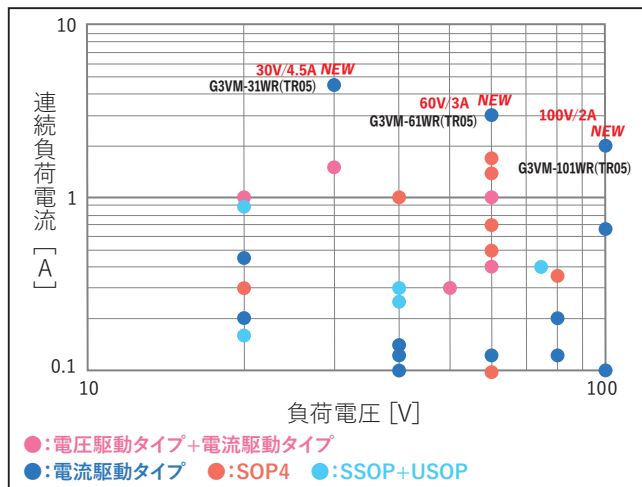
27.3mm²

7.1mm²

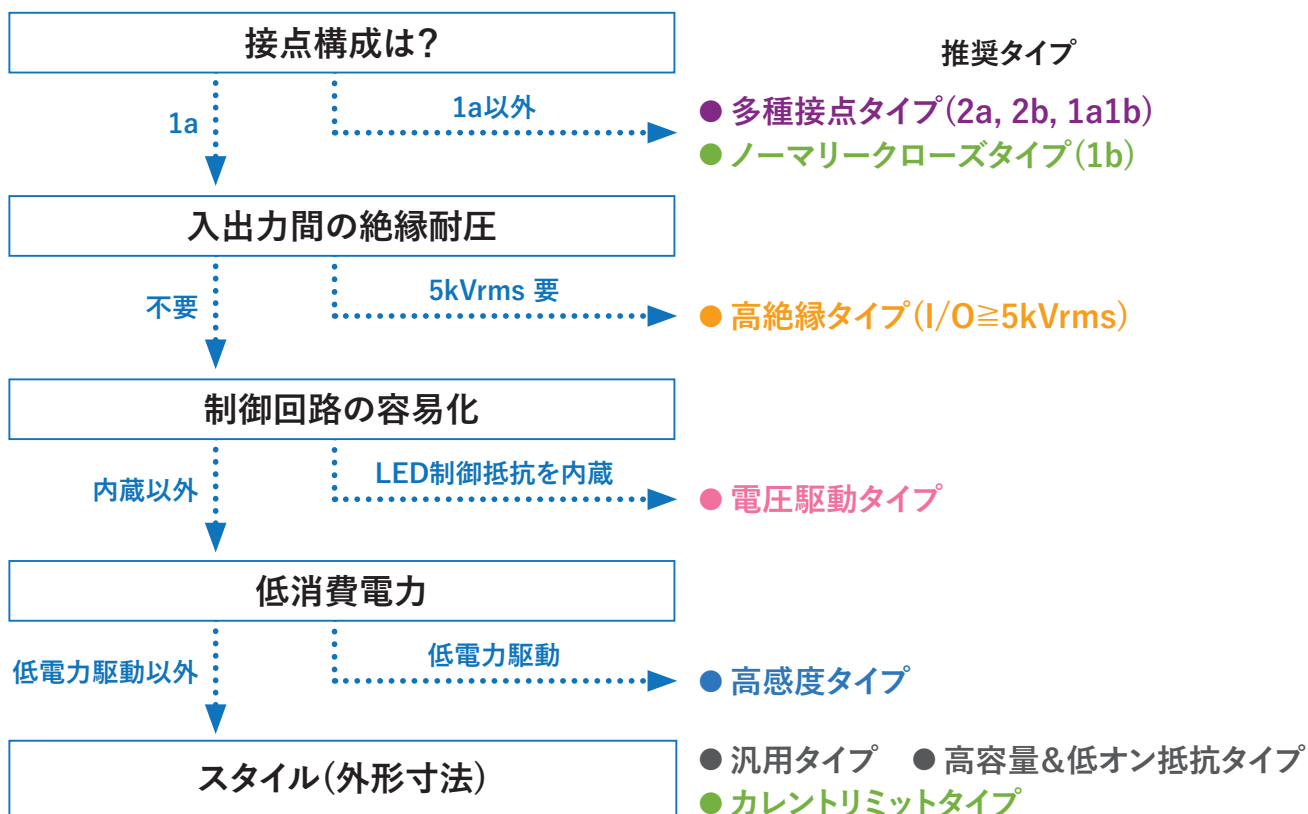


SOP4

P-SON



商品選定ガイド



パッケージ別 特性一覧(巻末)

DIP	SOP	SSOP	USOP	P-SON	VSON (R)	VSON	S-VSON
実装面積 100%とすると	実装面積 62%	実装面積 24%	実装面積 20%	実装面積 19%	実装面積 10%	実装面積 9%	実装面積 8%

*VSONに対して84%

MOS FETリレー おすすめラインアップ

多種接点タイプ(2a,2b,1a1b)／ノーマリークローズタイプ(1b)

お客様のご用途に合わせて多種接点タイプ、およびノーマリークローズタイプのMOS FETリレーをラインアップ。

多種接点タイプ

パッケージ	形名仕様	接点	負荷電圧 (V)	連続負荷電流 (A)
DIP8	G3VM-62C1/F1	2a	60	0.50
DIP8	G3VM-352C/F	2a	350	0.12
DIP8	G3VM-402C/F	2a	400	0.12
SOP8	G3VM-62J1	2a	60	0.40
SOP8	G3VM-202J1	2a	200	0.20
SOP8	G3VM-352J	2a	350	0.11
SOP8	G3VM-402J	2a	400	0.12
DIP8	G3VM-354C/F	2b	350	0.15
SOP8	G3VM-354J	2b	350	0.12
DIP8	G3VM-355CR/FR	1a1b	350	0.12
SOP8	G3VM-355JR	1a1b	350	0.12

ノーマリークローズタイプ

パッケージ	形名仕様	接点	負荷電圧 (V)	連続負荷電流 (A)
SOP4	G3VM-63G	1b	60	0.50
SOP4	G3VM-353G	1b	350	0.12
SOP6	G3VM-353H	1b	350	0.12
DIP4	G3VM-353A/D	1b	350	0.15
DIP6	G3VM-353B/E	1b	350	0.15

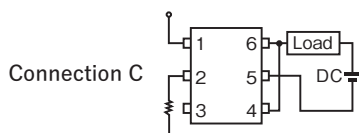
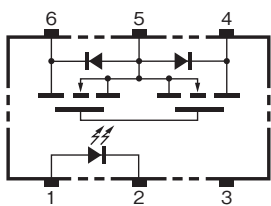
汎用タイプ

色々な用途でご使用いただける汎用タイプ。アナログ信号の開閉においてお迷いの際は、こちらを参照ください。

パッケージ	形名仕様	接点	負荷電圧 (V)	連続負荷電流 (A)
SOP4	G3VM-41GR8	1a	40	1
SOP4	G3VM-41GR5	1a	40	0.30
SOP4特殊	G3VM-61VY2	1a	60	0.50
SOP4特殊	G3VM-61VY3	1a	60	0.70
SOP4	G3VM-201G1	1a	200	0.20
SOP4特殊	G3VM-351VY	1a	350	0.11
SOP4	G3VM-401G1	1a	400	0.10
SOP4特殊	G3VM-401VY	1a	400	0.11
SOP4	G3VM-401G	1a	400	0.12

高容量&低オン抵抗タイプ

より高電流を流すことが可能なタイプ。機器での発熱低減や損失低減へと貢献いたします。



パッケージ	形名仕様	接点	負荷電圧 (V)	連続負荷電流 (A)*
DIP6	G3VM-31BR/ER	1a	30	5.0 (10)
DIP6	G3VM-61BR2/ER2	1a	60	4.0 (8)
DIP6	G3VM-101BR1/ER1	1a	100	3.5 (7)
SOP6	G3VM-31HR1	1a	30	4.5 (9)
SOP6	G3VM-61HR2	1a	60	4.0 (8)
SOP6	G3VM-101HR2	1a	100	3.0 (6)

*()C接続の場合(DC負荷のみ)

パッケージ	形名仕様	接点	負荷電圧 (V)	連続負荷電流 (A)
DIP4	G3VM-31AR/DR	1a	30	4
DIP4	G3VM-61AR1/DR1	1a	60	3
DIP4	G3VM-101AR1/DR1	1a	100	2

MOS FETリレー おすすめラインアップ

高絶縁タイプ (I/O \geq 5kVrms)

入出力間での絶縁性を求められるお客様へに向けた高絶縁タイプのMOS FETリレー

パッケージ	形名仕様	接点	負荷電圧 (V)	連続負荷電流 (A)	入出力間耐圧 (Vrms)
DIP4	G3VM-41AY1/DY1	1a	40	2	5,000
DIP4	G3VM-61AY1/DY1	1a	60	0.5	5,000
DIP4	G3VM-201AY1/DY1	1a	200	0.25	5,000
DIP4	G3VM-351AY1/DY1	1a	350	0.1	5,000
DIP4	G3VM-401AY1/DY1	1a	400	0.12	5,000
DIP4	G3VM-601AY1/DY1	1a	600	0.09	5,000

電圧駆動タイプ

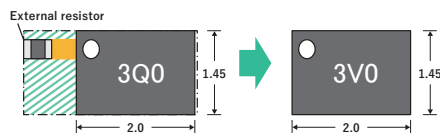
小型を求められるお客様へに向けた入力側の抵抗選定を省略いただける電圧駆動タイプのMOS FETリレー

S-VSON (existing)

Use with input current limiting resistor
Mounting area 2.90mm² + resistor area

S-VSON(L) voltage driven

Built-in input current limiting resistor
Mounting area 2.90mm²



パッケージ	形名仕様	接点	負荷電圧 (V)	連続負荷電流 (A)	動作入力電圧 (V)
VSON(R)4	G3VM-21UV11	1a	20	1.0	\leq 5.0
VSON(R)4	G3VM-51UV	1a	50	0.3	\leq 5.0
VSON(R)4	G3VM-61UV	1a	60	0.4	\leq 5.0
S-VSON(L)4	G3VM-31QVH	1a	30	1.5	\leq 5.0
S-VSON(L)4	G3VM-31QVL	1a	30	1.5	\leq 2.5
S-VSON(L)4	G3VM-61QVH	1a	60	0.4	\leq 5.0
S-VSON(L)4	G3VM-61QV2H	1a	60	1.0	\leq 5.0
S-VSON(L)4	G3VM-61QV2L	1a	60	1.0	\leq 2.5

高感度タイプ

ON動作に必要な入力電流を低減した高感度タイプのMOS FETリレー

パッケージ	形名仕様	接点	負荷電圧 (V)	連続負荷電流 (A)	トリガLED順電流(最大) (mA)	推奨動作LED順電流(標準) (mA)
SOP4	G3VM-61G2	1a	60	0.40	1	2
SOP4	G3VM-61G3	1a	60	0.40	0.2	0.5
SOP4	G3VM-201G1	1a	200	0.20	1	2
SOP4	G3VM-201G2	1a	200	0.20	0.2	0.5
SOP4	G3VM-351G1	1a	350	0.10	1	2
SOP4	G3VM-401G1	1a	400	0.10	0.2	0.5
SOP4	G3VM-601G	1a	600	0.09	1	2
SOP4	G3VM-601G1	1a	600	0.07	0.2	0.5

カレントリミットタイプ

過剰電流を抑制する保護機能を搭載したMOS FETリレー

パッケージ	形名仕様	接点	負荷電圧 (V)	連続負荷電流 (A)	リミット電流 (mA)
DIP4	G3VM-2L/2FL	1a	350	0.12	150~300
DIP8	G3VM-WL/WFL	2a	350	0.12	150~300

MOS FETリレー 商品ラインアップINDEX

詳細な測定条件等は、WEBページもしくは個別カタログをご確認ください。

DIP (Dual Inline Package = デュアル・インライン・パッケージ)										
負荷電圧 (最大) (V)	形式	端子数	接点構成	連続負荷電流 (最大) (mA)	最大出力オン抵抗 (標準) (Ω)	開路時漏れ電流 (最大) (nA)	端子間容量 (標準) (pF)	動作時間 (最大) (ms)	復帰時間 (最大) (ms)	入出力間耐電圧 (Vrms)
20	形G3VM-21AR/DR	4	1a	3000	0.04	1000	300	5.0	1.0	2500
20	形G3VM-21BR/ER	6	1a	4000 (8000) *1	0.02	1000	1000	5.0	1.0	2500
30	形G3VM-31AR/DR	4	1a	4000	0.025	1000	450	3.0	1.0	2500
30	形G3VM-31BR/ER	6	1a	5000 (10000) *1	0.02	1000	1100	5.0	0.5	2500
40	形G3VM-41AY1/DY1	4	1a	2000	0.09	1000	300	5.0	1.0	5000
40	形G3VM-41AR/DR	4	1a	2500	0.05	1000	300	5.0	1.0	2500
40	形G3VM-41BR/ER	6	1a	3500 (7000) *1	0.03	1000	1000	5.0	1.0	2500
60	形G3VM-61AY1/DY1	4	1a	500	0.6	1000	130	3.0	1.0	5000
60	形G3VM-61AR/DR	4	1a	2000	0.08	1000	250	5.0	1.0	2500
60	形G3VM-61AR1/DR1	4	1a	3000	0.045	1000	250	2.0	1.0	2500
60	形G3VM-61B1/E1	6	1a	500 (1000) *1	1	1000	130	2.0	0.5	2500
60	形G3VM-61BR/ER	6	1a	2500	0.065	10	400	3	0.6	2500
60	形G3VM-61BR1/ER1	6	1a	3000 (6000) *1	0.04	1000	1000	5.0	1.0	2500
60	形G3VM-61BR2/ER2	6	1a	4000 (8000) *1	0.035	1000	640	5.0	0.5	2500
60	形G3VM-61CR1/FR1	8	1a	5000(10000) *1	0.022	10000	850	5.0	1.0	2500
60	形G3VM-62C1/F1	8	2a	500	1	1000	130	2.0	0.5	2500
100	形G3VM-101AR/DR	4	1a	1000	0.25	1000	200	5.0	1.0	2500
100	形G3VM-101AR1/DR1	4	1a	2000	0.11	1000	110	2.0	0.5	2500
100	形G3VM-101BR/ER	6	1a	2000 (4000) *1	0.1	1000	1000	5.0	1.0	2500
100	形G3VM-101BR1/ER1	6	1a	3500 (7000) *1	0.05	1000	450	5.0	0.5	2500
100	形G3VM-101CR/FR	8	1a	3000 (6000) *1	0.06	1000	720	5.0	1.0	2500
200	形G3VM-201AY1/DY1	4	1a	250	5	1000	90	3.0	1.0	5000
200	形G3VM-201AR/DR	4	1a	700	0.9	1000	110	1.0	0.5	2500
200	形G3VM-201CR/FR	8	1a	1500 (3000) *1	0.25	1000	400	5.0	1.0	2500
350	形G3VM-351AY1/DY1	4	1a	100	35	1000	30	2.0	1.0	5000
350	形G3VM-2L/2FL	4	1a	120 *2	22	1000	40	1.0	1.0	2500
350	形G3VM-351A/D	4	1a	120	35	1000	30	1.0	1.0	2500
350	形G3VM-353A/D	4	1b	150	15	1000	85	1.0	3.0	2500
350	形G3VM-351B/E	6	1a	120 (240) *1	35	1000	30	1.0	1.0	2500
350	形G3VM-353B/E	6	1b	150 (300) *1	15	1000	85	1.0	3.0	2500
350	形G3VM-355CR/FR	8	1a1b	120	15	1000	65	1.0	3.0	2500
350	形G3VM-352C/F	8	2a	120	35	1000	30	1.0	1.0	2500
350	形G3VM-WL/WFL	8	2a	120 *2	22	1000	40	1.0	1.0	2500
350	形G3VM-354C/F	8	2b	150	15	1000	85	1.0	3.0	2500
400	形G3VM-401A/D	4	1a	120	18	1000	40	1.0	1.0	2500
400	形G3VM-401AY1/DY1	4	1a	120	22	1000	80	2.0	1.0	5000
400	形G3VM-401B/E	6	1a	120 (240) *1	17	1000	40	1.0	1.0	2500
400	形G3VM-401BY/EY	6	1a	120 (240) *1	17	1000	40	1.0	1.0	5000
400	形G3VM-401CR/FR	8	1a	400 (800) *1	3	1000	410	1.0	1.0	2500
400	形G3VM-402C/F	8	2a	120	18	1000	40	1.0	1.0	2500
600	形G3VM-601AY1/DY1	4	1a	90	45	1000	75	2.0	1.0	5000
600	形G3VM-601BY/EY	6	1a	100 (200) *1	30	1000	120	1.5	1.0	5000
600	形G3VM-601CR/FR	8	1a	600 (1200) *1	1.3	10000	4300	3.0	1.0	2500

*1. ()C接続の場合(DC負荷のみ) *2. カレントリミット機能付き(リミット電流 150mA~300mA)

注. 使用周囲温度: ★-40~+110°C、◆-40~+105°C、○-20~+85°C、その他は、-40~+85°C

MOS FETリレー 商品ラインアップINDEX

詳細な測定条件等は、WEBページもしくは個別カタログをご確認ください。

SOP (Small Outline Package = スモール・アウトライン・パッケージ)

負荷電圧 (最大) (V)	形式	端子数	接点構成	連続負荷電流 (最大) (mA)	最大出力オン抵抗 (標準) (Ω)	開路時漏れ電流 (最大) (nA)	端子間容量 (標準) (pF)	動作時間 (最大) (ms)	復帰時間 (最大) (ms)	入出力間耐電圧 (Vrms)	
20	形G3VM-21GR	4	1a	160	5	1	1	0.5	0.5	1500	○
20	形G3VM-21GR1	4	1a	300	1	1	5	0.5	0.5	1500	○
20	形G3VM-21HR	6	1a	2500 (5000) *1	0.02	10	1000	5.0	1.0	1500	
30	形G3VM-31HR	6	1a	4000 (8000) *1	0.02	1000	1100	5.0	1.0	1500	
30	形G3VM-31HR1	6	1a	4500 (9000) *1	0.022	1000	1200	2.0	0.5	1500	★
40	形G3VM-41GR6	4	1a	120	10	1	1	0.5	0.5	1500	○
40	形G3VM-41GR4	4	1a	250	2	1	5	0.5	0.5	1500	○
40	形G3VM-41GR5	4	1a	300	1	1	10	0.5	0.5	1500	
40	形G3VM-41GR8	4	1a	1000	0.1	1	300	3.0	0.5	1500	
40	形G3VM-41HR	6	1a	2500 (5000) *1	0.03	10	1000	5.0	1.0	1500	
60	形G3VM-61VY1 *3	4	1a	100	25	1000	10	5.0	5.0	3750	
60	形G3VM-61G2	4	1a	400	1	1000	130	8.0	3.0	1500	
60	形G3VM-61G3	4	1a	400	1	1000	130	10.0	5.0	1500	
60	形G3VM-61VY2 *3	4	1a	500	1	1000	20	2.0	0.5	3750	★
60	形G3VM-61VY3 *3	4	1a	700	0.15	1000	100	3.0	0.5	3750	★
60	形G3VM-61GR2	4	1a	1700	0.08	10	250	3.0	0.5	1500	
60	形G3VM-61VR *3	4	1a	1400	0.13	1000	100	3.0	1.0	3750	★
60	形G3VM-63G	4	1b	500	1	1000	100	1.0	3.0	1500	★
60	形G3VM-61H1	6	1a	400 (800) *1	1	1000	130	2.0	0.5	1500	
60	形G3VM-61HR	6	1a	2300 (4600) *1	0.04	10	1000	5.0	1.0	1500	
60	形G3VM-61HR1	6	1a	3300 (6600) *1	0.03	20	700	5.0	1.0	1500	
60	形G3VM-61HR2	6	1a	4000 (8000) *1	0.028	1000	750	2.0	0.5	1500	★
60	形G3VM-62J1	8	2a	400	1	1000	130	2.0	0.5	1500	
80	形G3VM-81GR	4	1a	40	16	1	2.5	0.5	0.5	1500	○
80	形G3VM-81GR1	4	1a	200	5	1	6.5	0.5	0.5	1500	○
80	形G3VM-81G1	4	1a	350	1	1	30	0.5	0.5	1500	○
80	形G3VM-81HR	6	1a	1250 (2500) *1	0.11	1.5	460	3.0	1.0	1500	○
100	形G3VM-101HR	6	1a	1400 (2800) *1	0.1	10	1000	5.0	1.0	1500	
100	形G3VM-101HR1	6	1a	2000 (4000) *1	0.045	1000	500	5.0	1.0	1500	
100	形G3VM-101HR2	6	1a	3000 (6000) *1	0.05	1000	460	2.0	0.5	1500	★
200	形G3VM-201G	4	1a	50	40	1	15	0.5	0.2	1500	
200	形G3VM-201G1	4	1a	200	5	1000	90	8.0	3.0	1500	
200	形G3VM-201G2	4	1a	200	5	1000	90	10.0	5.0	1500	
200	形G3VM-S5	4	1a	200	5	1000	100	1.5	1.0	1500	
200	形G3VM-201H1	6	1a	200 (400) *1	5	1000	100	1.5	1.0	1500	
200	形G3VM-202J1	8	2a	200	5	1000	100	1.5	1.0	1500	
350	形G3VM-351G1	4	1a	100	35	1000	35	5.0	3.0	1500	
350	形G3VM-351VY *3	4	1a	110	35	1000	30	1.0	0.5	3750	★
350	形G3VM-351GL	4	1a	120 *2	15	1000	70	1.0	1.0	1500	
350	形G3VM-353G	4	1b	120	15	1000	65	1.0	3.0	1500	
350	形G3VM-351H	6	1a	110 (220) *1	35	1000	30	1.0	1.0	1500	
350	形G3VM-353H	6	1b	120 (240) *1	15	1000	65	1.0	3.0	1500	
350	形G3VM-355JR	8	1a1b	120	15	1000	65	1.0	3.0	1500	
350	形G3VM-352J	8	2a	110	35	1000	30	1.0	1.0	1500	
350	形G3VM-354J	8	2b	120	15	1000	65	1.0	3.0	1500	
400	形G3VM-401G1	4	1a	100	18	1000	70	10.0	5.0	1500	
400	形G3VM-401G	4	1a	120	17	1000	70	1.0	1.0	1500	
400	形G3VM-401VY *3	4	1a	110	40	1000	30	1.0	0.5	3750	★
400	形G3VM-401H	6	1a	120 (240) *1	17	1000	70	1.0	1.0	1500	
400	形G3VM-402J	8	2a	120	17	1000	70	1.0	1.0	1500	
600	形G3VM-601G1	4	1a	70	35	1000	75	10.0	5.0	1500	
600	形G3VM-601G	4	1a	90	45	1000	75	8.0	3.0	1500	

*1. ()の値は、C接続の場合(DC負荷のみ) *2. カレントリミット機能付き(リミット電流 150mA~300mA) *3. VY1、VY2、VY3、VRタイプは、SOP4ピン(特殊)パッケージ
注. 使用周囲温度：★-40~+110°C、◆-40~+105°C、○-20~+85°C、その他は、-40~+85°C

MOS FETリレー 商品ラインアップINDEX

詳細な測定条件等は、WEBページもしくは個別カタログをご確認ください。

SSOP (Shrink Small Outline Package = シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ)

負荷電圧 (最大) (V)	形式	端子数	接点構成	連続負荷電流 (最大) (mA)	最大出力オン抵抗 (標準) (Ω)	開路時漏れ電流 (最大) (nA)	端子間容量 (標準) (pF)	動作時間 (最大) (ms)	復帰時間 (最大) (ms)	入出力間耐電圧 (Vrms)
20	形G3VM-21LR	4	1a	160	5	1	1	0.5	0.5	1500
20	形G3VM-21LR10	4	1a	200	3	0.2	0.8	0.2	0.2	1500
20	形G3VM-21LR1	4	1a	450	0.8	1	5	0.5	0.5	1500
20	形G3VM-21LR11	4	1a	900	0.18	1	40	2.0	1.0	1500
40	形G3VM-41LR6	4	1a	120	10	1	1	0.5	0.5	1500
40	形G3VM-41LR10	4	1a	120	12	0.2	0.45	0.2	0.3	1500
40	形G3VM-41LR11	4	1a	140	7	0.2	0.7	0.2	0.2	1500
40	形G3VM-41LR4	4	1a	250	2	1	5	0.5	0.5	1500
40	形G3VM-41LR5	4	1a	300	1	1	10	0.5	0.5	1500
60	形G3VM-61LR	4	1a	400	1	1000	20	1.0	1.0	1500
80	形G3VM-81LR	4	1a	120	7.5	0.2	5	0.25	0.2	1500
100	形G3VM-101LR	4	1a	80	8	0.2	6	0.3	0.3	1500

注. 使用周囲温度: -20~+85°C

P-SON (Power Small Outline Non-leaded = パワー・スモール・アウトライン・ノンリーデッド)

負荷電圧 (最大) (V)	形式	端子数	接点構成	連続負荷電流 (最大) (mA)	最大出力オン抵抗 (標準) (Ω)	開路時漏れ電流 (最大) (nA) *	端子間容量 (標準) (pF)	動作時間 (最大) (ms)	復帰時間 (最大) (ms)	入出力間耐電圧 (Vrms)
30	形G3VM-31WR	4	1a	4500	0.025	10	450	5	1	500
60	形G3VM-61WR	4	1a	3000	0.045	10	250	5	1	500
100	形G3VM-101WR	4	1a	2000	0.13	10	170	3	1	500
200	形G3VM-201WR	4	1a	350	4.5	10	75	1	1	500

*測定条件については、カタログを参照ください

USOP (Ultra Small Outline Package = ウルトラ・スモール・アウトライン・パッケージ)

負荷電圧 (最大) (V)	形式	端子数	接点構成	連続負荷電流 (最大) (mA)	最大出力オン抵抗 (標準) (Ω)	開路時漏れ電流 (最大) (nA)	端子間容量 (標準) (pF)	動作時間 (最大) (ms)	復帰時間 (最大) (ms)	入出力間耐電圧 (Vrms)
20	形G3VM-21PR10	4	1a	200	3	1	0.8	0.2	0.2	500
20	形G3VM-21PR1	4	1a	450	0.6	1	5	0.5	0.5	500
20	形G3VM-21PR11	4	1a	900	0.18	1	40	2.0	1.0	500
40	形G3VM-41PR12	4	1a	100	15	1	0.3	0.2	0.2	500
40	形G3VM-41PR10	4	1a	120	12	1	0.45	0.2	0.3	500
40	形G3VM-41PR6	4	1a	120	10	0.2	1	0.2	0.3	500
40	形G3VM-41PR11	4	1a	140	7	1	0.7	0.2	0.2	500
40	形G3VM-41PR5	4	1a	300	1	1	10	0.5	0.3	500
50	形G3VM-51PR	4	1a	300	1	1	12	0.5	0.4	500
60	形G3VM-61PR1	4	1a	120	10	1	0.7	0.2	0.2	500
60	形G3VM-61PR	4	1a	400	1	1	20	0.5	0.5	500
75	形G3VM-71PR	4	1a	400	1	1	30	2.0	1.0	500
80	形G3VM-81PR	4	1a	120	7	0.02	5	0.5	0.2	500
100	形G3VM-101PR	4	1a	100	8	0.2	6	0.3	0.3	500

注. 使用周囲温度: -40~+85°C

VSON(R) (Very Small Outline Package Non-leaded with Resistance = ベリー・スモール・アウトライン・パッケージ・ノンリーデッドwith レジスタンス) 電圧駆動タイプ

負荷電圧 (最大) (V)	形式	端子数	接点構成	連続負荷電流 (最大) (mA)	最大出力オン抵抗 (標準) (Ω)	開路時漏れ電流 (最大) (nA)	端子間容量 (標準) (pF)	動作時間 (最大) (ms)	復帰時間 (最大) (ms)	推奨動作入力順電圧(標準)(V)	入出力間耐電圧 (Vrms)
20	形G3VM-21UV11	4	1a	1000	0.18	1	40	2.0	1.0	5	500
50	形G3VM-51UV	4	1a	300	1	1	12	0.5	0.4	5	500
60	形G3VM-61UV	4	1a	400	1	1	20	0.5	0.5	5	500

注. 使用周囲温度: -40~+110°C

VSON (Very Small Outline Package Non-leaded = ベリー・スモール・アウトライン・パッケージ・ノンリーデッド)

負荷電圧 (最大) (V)	形式	端子数	接点構成	連続負荷電流 (最大) (mA)	最大出力オン抵抗 (標準) (Ω)	開路時漏れ電流 (最大) (nA)	端子間容量 (標準) (pF)	動作時間 (最大) (ms)	復帰時間 (最大) (ms)	入出力間耐電圧 (Vrms)
20	形G3VM-21UR10	4	1a	200	3	1	0.8	0.2	0.2	500
20	形G3VM-21UR1	4	1a	450	0.8	1	5	0.4	0.4	500
20	形G3VM-21UR11	4	1a	1000	0.18	1	40	2.0	1.0	500
40	形G3VM-41UR12	4	1a	100	15	1	0.3	0.2	0.2	500
40	形G3VM-41UR10	4	1a	120	12	1	0.45	0.2	0.3	500
40	形G3VM-41UR11	4	1a	140	5	1	0.7	0.2	0.2	500
50	形G3VM-51UR	4	1a	300	1	1	12	0.5	0.4	500
60	形G3VM-61UR1	4	1a	120	10	1	0.7	0.2	0.2	500
60	形G3VM-61UR	4	1a	400	1	1	20	0.5	0.5	500
80	形G3VM-81UR	4	1a	120	7	0.02	5	0.5	0.2	500
80	形G3VM-81UR1	4	1a	200	6	1	6.5	0.4	0.4	500
100	形G3VM-101UR	4	1a	100	8	0.2	6	0.3	0.3	500

注. 使用周囲温度: -40~+110°C

S-VSON (Super - Very Small Outline Package Non-leaded = スーパー ベリー・スモール・アウトライン・パッケージ・ノンリーデッド)

負荷電圧 (最大) (V)	形式	端子数	接点構成	連続負荷電流 (最大) (mA)	最大出力オン抵抗 (標準) (Ω)	開路時漏れ電流 (最大) (nA)	端子間容量 (標準) (pF)	動作時間 (最大) (ms)	復帰時間 (最大) (ms)	入出力間耐電圧 (Vrms)
30	形G3VM-31QR	4	1a	1500	0.1	1	120	2.0	1.0	500
40	形G3VM-41QR10 *	4	1a	120	11	1	0.45	0.2	0.3	500
60	形G3VM-61QR	4	1a	400	1.1	1	12	0.5	0.3	500
60	形G3VM-61QR2	4	1a	1000	0.2	1	80	2.0	0.3	500
100	形G3VM-101QR1	4	1a	650	0.4	1	50	2.0	0.3	500

* 41QR10タイプは、S-VSON(L) 低背形パッケージ

注. 使用周囲温度: -40~+110°C

S-VSON (Super - Very Small Outline Package Non-leaded = スーパー ベリー・スモール・アウトライン・パッケージ・ノンリーデッド) 電圧駆動タイプ

負荷電圧 (最大) (V)	形式	端子数	接点構成	連続負荷電流 (最大) (mA)	最大出力オン抵抗 (標準) (Ω)	開路時漏れ電流 (最大) (nA)	端子間容量 (標準) (pF)	動作時間 (最大) (ms)	復帰時間 (最大) (ms)	推奨動作入力順電圧(標準)(V)	入出力間耐電圧 (Vrms)
30	形G3VM-31QVH	4	1a	1500	0.1	1	120	2	0.2	5	500
30	形G3VM-31QVL	4	1a	1500	0.1	1	120	2	0.2	2.5	500
60	形G3VM-61QV2H	4	1a	1000	0.2	1	80	2	0.2	5	500
60	形G3VM-61QV2L	4	1a	1000	0.2	1	80	1	0.2	2.5	500
60	形G3VM-61QVH	4	1a	400	1	1	20 (最大)	0.5	0.2	5	500

* S-VSON(L) 低背形パッケージ

注. 使用周囲温度: -40~+110°C

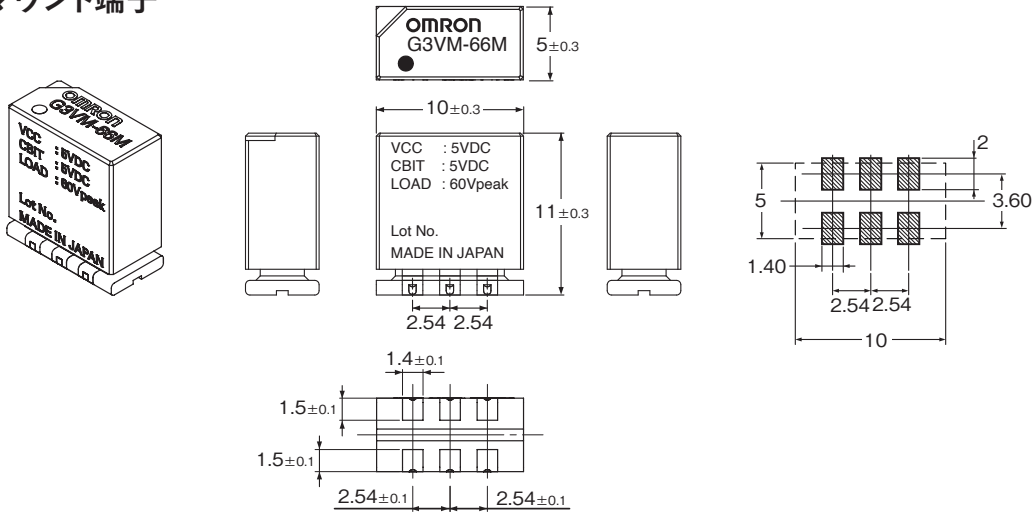
MOS FETリレーモジュール パッケージ外形寸法図・外観例

(単位:mm)

SPDT モジュール

サーフェス・マウント端子

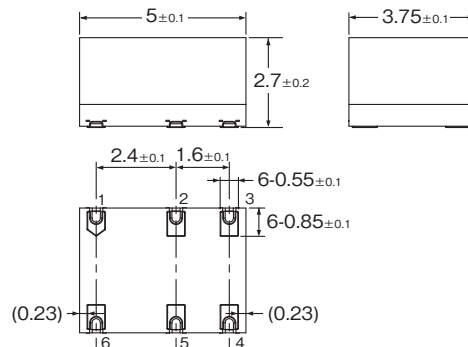
質量:1g



T-モジュール

サーフェス・マウント端子

質量:0.11g



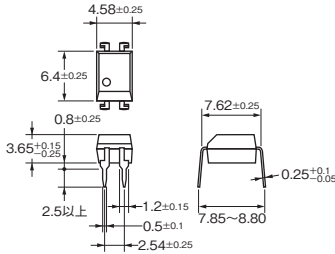
MOS FETリレー パッケージ外形寸法図・外観例

(単位:mm)

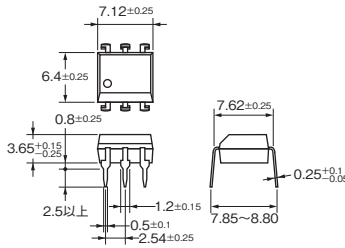
DIP (Dual In-line Package)

プリント基板用端子

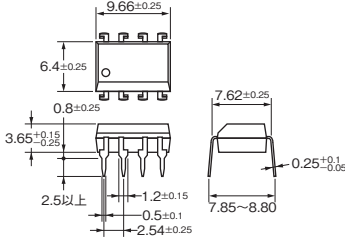
■DIP4ピン 質量：0.25g



■DIP6ピン 質量：0.4g

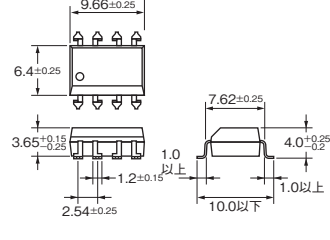
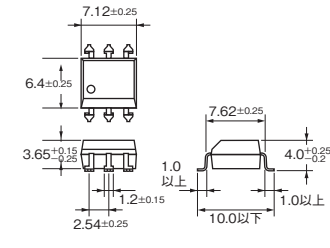


■DIP8ピン 質量：0.54g



サーフェス・マウント端子

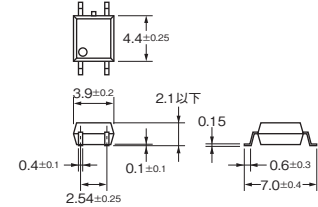
(G3VM-61BR/ERを除く)



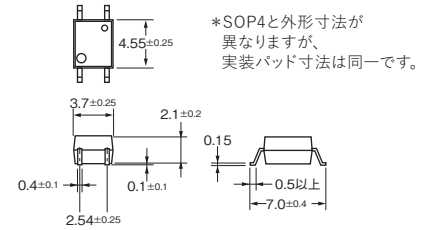
SOP (Small Outline Package)

サーフェス・マウント端子

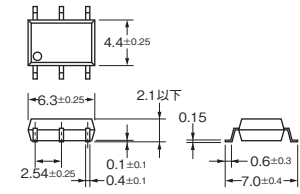
■SOP4ピン 質量：0.1g



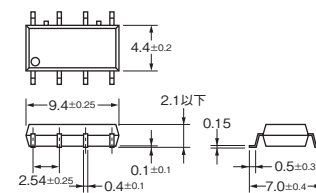
■SOP4ピン (特殊) 質量：0.1g



■SOP6ピン 質量：0.13g



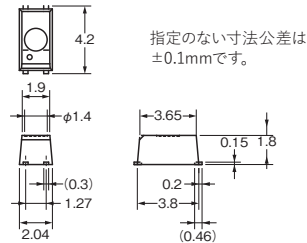
■SOP8ピン 質量：0.2g



SSOP (Shrink Small Outline Package)

サーフェス・マウント端子

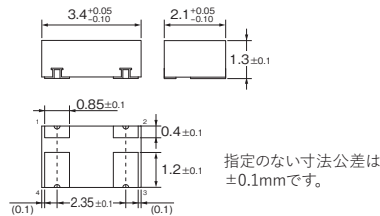
■SSOP4ピン 質量：0.03g



P-SOP (Power Small Outline Non-leaded)

サーフェス・マウント端子

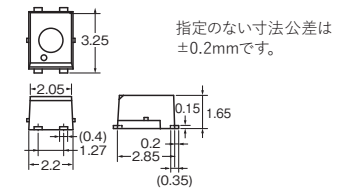
■P-SOP4ピン 質量：0.02g



USOP (Ultra Small Outline Package)

サーフェス・マウント端子

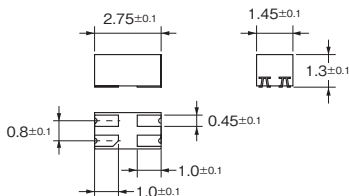
■USOP4ピン 質量：0.03g



VSON(R) (Very Small Outline Non-Leaded with Resistor)

サーフェス・マウント端子

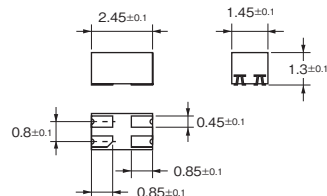
■VSON(R) 4ピン 質量：0.01g



VSON (Very Small Outline Non-leaded)

サーフェス・マウント端子

■VSON4ピン 質量：0.01g

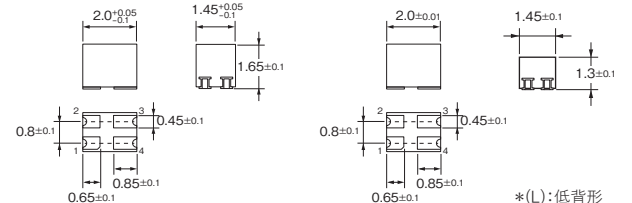


S-VSON (Super Very Small Outline Non-leaded)

サーフェス・マウント端子

■S-VSON4ピン 質量：0.01g

■S-VSON(L)*4ピン 質量：0.01g



MEMO

Dotted lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

- 本誌に記載の商品の価格は、お取引先にお問い合わせください。
- ご注文の際には下記URLに掲載の「ご承諾事項」を必ずお読みください。
適合用途の条件、保証内容などご注文に際してのご承諾事項をご説明しております。
https://components.omron.com/jp-ja/sales_terms-and-conditions

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

- 製品に関するお問い合わせ先
お客様相談室

フリーダイヤル **0120-919-066**

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 **055-982-5015** (通話料がかかります)

▼チャットはこちら

オムロンFAクイックチャット
www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)

■営業時間：9:00～17:00(12:00～13:00除く) ■営業日：平日

※営業時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。

- その他のお問い合わせ

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。

オムロン商品のご用命は